

**Silicijevе planarne signalne diode**  
**Silicon planar signal diodes**

Tip/Type		$U_{BR}$	$I_{FAV}$	$U_F$ pri/at $I_F$		$I_R$		$C$	$t_{tr}$		Sl./Fig.
		100 $\mu A$	$\Delta_{amb} = 25^\circ C$	$\Delta_{amb} = 25^\circ C$		pri/at 25 $^\circ C$	pri/at $U_R$	pri/at 1 MHz $U_R = OV$			
		(V)	(mA)	(V)	(mA)	(nA)	(V)	(pF)	(ns)		
BA 511	1N4148	100	150	1.0	10	25	20	4	4 <sup>1</sup>	8 <sup>2</sup>	1
BA 513	1N4448	100	150	1.0	100	25	20	4	4 <sup>1</sup>	8 <sup>2</sup>	
BA 517	1N4150	70	200	1.0	200	100	50	2,5	4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 518	1N4151	75	150	1.0	50	50	50	2	2 <sup>1</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 519	1N4152	40	150	0.88	20	50	30	2	2 <sup>1</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 520	1N4153	75	150	0.88	20	50	50	2	2 <sup>1</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 521	1N4154	35	150	1.0	30	100	25	4	2 <sup>1</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 523	1N4444	70	200	1.0	100	50	50	2	7 <sup>2</sup>	7 <sup>2</sup>	
BA 531	1N4727	30	150	0.85	10	100	20	4	4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	
BA 533	1N4864	125	200	1.1	100	100	80	1.3	4 <sup>1</sup>	8 <sup>2</sup>	
BA 543	BAY 17	15	200	1.0	100	100	12	1.5	50 <sup>3</sup>	50 <sup>2</sup>	
BA 544	BAV 18	60	200	1.0	100	100	50	1.5	50 <sup>3</sup>	50 <sup>2</sup>	
BA 545	BAV 19	120	200	1.0	100	100	100	1.5	50 <sup>3</sup>	50 <sup>2</sup>	
BA 546	BAY 20	180	200	1.0	100	100	150	1.5	50 <sup>3</sup>	50 <sup>2</sup>	
BA 547	BAY 80	150	200	1.0	100	100	120	6	50 <sup>3</sup>	50 <sup>2</sup>	

\* pri/at 100 $^\circ C$

<sup>1</sup>  $I_F = 10$  mA,  $U_R = 6$  V,  $I_{RR} = 1$  mA,  $R_L = 100 \Omega$

<sup>2</sup>  $I_F = 10$  mA,  $I_R = 10$  mA,  $I_{RR} = 1$  mA

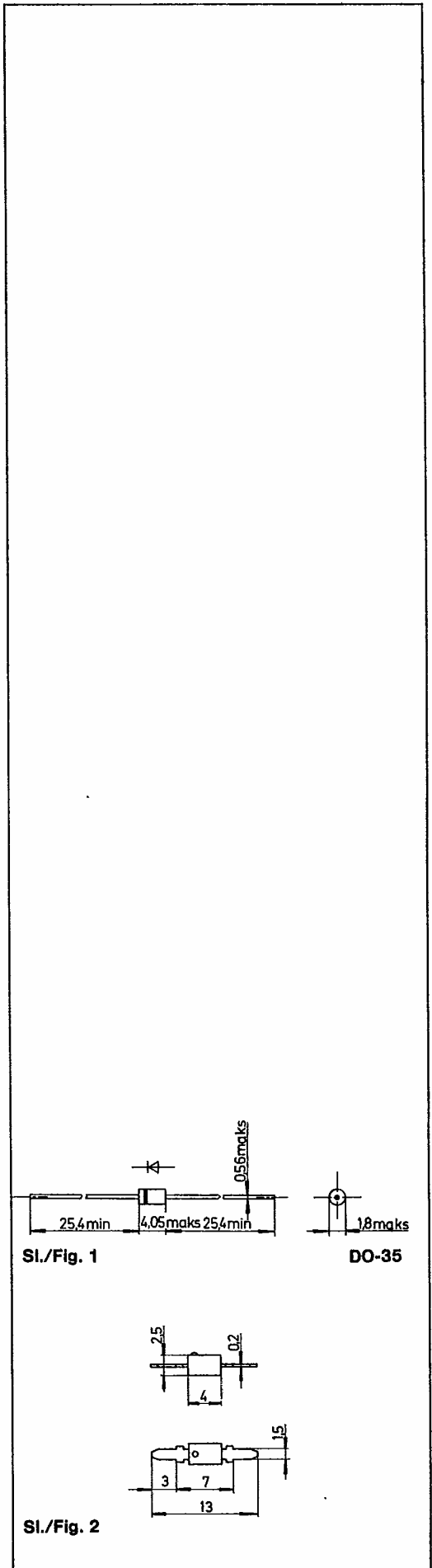
<sup>3</sup>  $I_F = 30$  mA,  $I_R = 30$  mA,  $I_{RR} = 3$  mA,  $R_L = 100 \Omega$

**Silicijevе preklonpne diode**  
**Silicon switching diodes**

Tip/Type	$U_{RRM}$	$I_F$	$\Delta_{sto}$	$U_F$ pri/at $I_F$		$C$ pri/at 1 MHz $U_R = 3$ V	$r_f$ pri/at $f = 100$ MHz $I_F = 10$ mA	Sl./Fig.
	(V)	(mA)	( $^\circ C$ )	(V)	(mA)	(pF)	( $\Omega$ )	
BA 244 A	20	100	-50 do/to +100	<1	100	<1,8	0,5	1
BA 182 A	20	100	-40 do/to +100	<1,2	100	<1,25	0,7	2

**Dioda s spremenljivo kapacitivnostjo**  
**Capacitance diodes**

Tip/Type	$U_{RRM}$	$C_r$ pri/at $U_R$ (1 MHz)		$C_r(U_{R1})$	$U_{R1}$	$U_{R2}$	$r_\theta$	Sl./Fig.
	(V)	(pF)	(V)	$C_r(U_{R2})$	(V)	(V)	( $\Omega$ )	
BB 105 A	30	2,3 do/to 2,8	25	4 do/to 5	3	25	0,8	2
BB 105 B		2 do/to 2,3	25	4,5 do/to 6	3	25	0,8	
BB 105 G		1,8 do/to 2,8	25	4 do/to 6	3	25	1,2	



DO-35

Sl./Fig. 1

Sl./Fig. 2